

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年12月12日(12.12.2024)



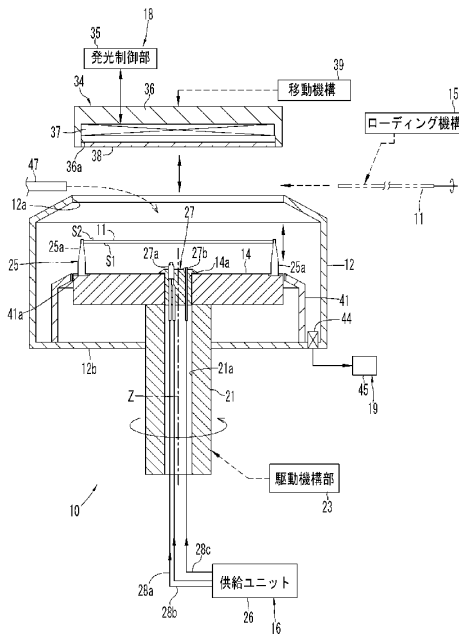
(10) 国際公開番号

WO 2024/252840 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) H01L 21/306 (2006.01)
H01L 21/027 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/017241
- (22) 国際出願日: 2024年5月9日(09.05.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-094879 2023年6月8日(08.06.2023) JP
- (71) 出願人: 株式会社ジェイ・イー・ティ(J.E.T. CO., LTD.) [JP/JP]; 〒7190302 岡山県浅口郡里庄町大字新庄字金山 6 0 7 8 番 Okayama (JP).
- (72) 発明者: 房野 正幸(BONO Masayuki); 〒7190302 岡山県浅口郡里庄町大字新庄字金山 6 0 7 8 番 株式会社ジェイ・イー・ティ内 Okayama (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人ドライト国際特許事務所(DORAIT IP LAW FIRM); 〒1600023 東京都新宿区西新宿六丁目15番1号 ラ・トゥール新宿4 1 1号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS

(54) 発明の名称: 基板処理装置



- 15 Loading mechanism
23 Drive mechanism part
26 Supply unit
35 Emission control part
39 Movement mechanism

(57) Abstract: Provided is a substrate processing apparatus capable of heating a substrate in a mode suitable for accurate temperature measurement. A heating part 18 heats a substrate 11 by irradiating the substrate 11 with light from LEDs 37a of a light source part 34. The LEDs 37a output light of a single wavelength having a peak wavelength in a wavelength region that does not pass through the substrate 11. A radiation thermometer 37b provided in an LED unit 37 detects light of a wavelength region not including the wavelength of the light output by the LEDs 37a, to measure the temperature of

[続葉有]

MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO(BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))

the substrate 11. An emission control part 35 increases or decreases the intensity of the light output by each LED 37a on the basis of the temperature of the substrate 11 measured by the radiation thermometer 37b.

(57) 要約: 正確な温度測定に適した態様で基板を加熱することができる基板処理装置を提供する。加熱部18は、光源部34のLED37aからの光を基板11に照射することによって基板11を加熱する。LED37aは、基板11を透過しない波長域にピーク波長を持つ単一波長の光を出力する。LEDユニット37に設けた放射温度計37bは、LED37aが出力する光の波長を含まない波長域の光を検出して基板11の温度を測定する。発光制御部35は、放射温度計37bによって測定した基板11の温度に基づいて、各LED37aが出力する光の強度を増減する。